

الله زنگنه



دانشگاه بیر جند

دانشکده مهندسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

## بررسی رشد ترک در صفحه‌ی گرافن

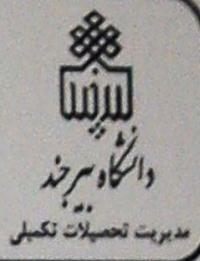
نگارش:

حسن حیرانی

استاد راهنما:

دکتر سید یوسف احمدی بروغنی

۱۳۹۰ مهر



فرم شماره ۱۰

## صورتجلسه دفاع از مامان نامه کارشناسی ارشد

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد آقای حسن حیرانی  
به شماره دانشجویی: ۸۸۱۳۳۲۲۰۱۱ رشته: مهندسی مکانیک گرایش: طراحی کاربردی دانشکده: مهندسی  
تحت عنوان:

بورسی رشد ترک در صفحه گرافن

به ارزش: ۶ واحد در ساعت: ۱۷ روز: شنبه مورخ: ۱۳۹۰/۷/۳۰

با حضور اعضای محترم جلسه دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی به شرح ذیل تشکیل گردید:

امضاء	رتبه علمی	نام و نام خانوادگی	سمت
	استادیار	سید یوسف احمدی بروغنى	استاد راهنمای اول
			استاد راهنمای دوم
			استاد مشاور اول
			استاد مشاور دوم
	دانشیار	سید حجت هاشمی	داور اول
	استادیار	سعید حیدری مود	داور دوم
	استادیار	مهدی راغبی	نماینده تحصیلات تکمیلی

نتیجه ارزیابی دفاع که منوط به ارائه اصلاحات پیشنهادی توسط هیئت داوران حداکثر ظرف مدت یکماه  
پس از تاریخ دفاع می باشد، به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت:

- قبول (با درجه عالی) و امتیاز: ۱۹/۱۳       غیر قابل قبول  
۱- عالی (۱۹-۲۰)    ۲- بسیار خوب (۱۸-۱۸/۹۹)    ۳- خوب (۱۷/۹۹-۱۶)    ۴- قابل قبول (۱۵/۹۹-۱۴)

(بدیهی است عواقب آموزشی ناشی از عدم ارائه به موقع اصلاحات مذبور به عهده دانشجو می باشد)

تَقْدِيمٌ بِهِ

خانواده عزیزم

## تشکر و قدردانی

ضمن سپاس بیشمار آفریدگار بی همتا، بدین وسیله از جناب آقای دکتر سید یوسف احمدی بروغنى استاد راهنمای ارجمند که زحمات زیادی در راستای انجام این پژوهش متحمل شده و از مراحل آغازین تا پایان کار راهنمای اینجنب بوده اند تشکر و قدردانی می کنم.  
از خانواده عزیزم که نه تنها در به سرانجام رساندن این پژوهش بلکه در تمامی مراحل زندگانی یاور و پشتیبانم بوده اند صمیمانه تشکر می نمایم.

حسن حیرانی

## چکیده

در این کار ابتدا یک مدل مکانیک محیط پیوسته برای بررسی خواص مکانیکی صفحات گرافن<sup>۱</sup> ارائه می شود. پایه‌ی مفهوم پیشنهادی این تصور است که صفحه‌ی گرافن یک سازه‌ی قاب-فضایی است، به این صورت که در نرم افزار انسیس مکان اتم‌های کربن در صفحه‌ی گرافن به عنوان گره و پیوند کوالانسی بین اتم‌های کربن با المان‌های BEAM23 تعریف شده است. خواص المان‌ها با برقراری یک ارتباط بین مدل مکانیک محیط پیوسته و ساختار اتمی مسئله‌پیدا می شود. ایجاد مدل در محیط نرم افزار انسیس با استفاده از قابلیت برنامه نویسی APDL<sup>۲</sup> نرم افزار انجام شده است. در قسمت‌های اولیه، تأثیر زاویه کایرال<sup>۳</sup> روی مدول کششی صفحه‌ی گرافن بررسی شده است. در تمامی مراحل کار از فرض تغییر شکل‌های بزرگ<sup>۴</sup> در نرم افزار استفاده گردیده است. محاسبات تغییر شکل الاستیک صفحات گرافن معلوم می کند که مدول کششی این صفحات مستقل از اندازه‌ی صفحه و تا حدودی وابسته به نوع صفحه و اندازه‌ی زاویه کایرالشان می باشد. مدول برشی صفحات گرافن وابسته به ابعادشان یافت شد. در ادامه تأثیر نقایص SW (Stone-Wales) و جای خالی<sup>۵</sup> بر خواص الاستیک گرافن بررسی شده است. نتایج اثرگذاری این نقایص بر تنش و کرنش شکست صفحات را نشان می دهد. در انتها، یک مدل شکست پیشرونده<sup>۶</sup> برای مدل سازی رشد ترک در صفحه‌ی گرافن ارائه شده است. ایجاد و شروع ترک در صفحه به دلیل وجود نقایص اتفاق می افتد. وجود نقایصی از قبیل نقص SW و نقص جای خالی در صفحات گرافن به اثبات رسیده است. بنابراین، این نقایص به عنوان نقایص اولیه در صفحه‌ی گرافن مدل شده، تا در حین بارگذاری ترک ایجاد گردد. مسیر پارگی و ترتیب شکست المان‌های صفحات گرافن مختلف در شکل‌هایی نشان داده شده است. نتایج توافق خوبی با کارهای پیشین نشان می دهند.

**کلید واژه:** المان محدود، ترک، کایرالیتی، گرافن، نقص

<sup>1</sup> Graphene sheets

<sup>2</sup> ANSYS Parametric Design Language

<sup>3</sup> Chiral

<sup>4</sup> Large-deformation

<sup>5</sup> Vacancy

<sup>6</sup> Progressive fracture

## فهرست مطالب

### صفحه

### عنوان

ج	فهرست علایم و نشانه‌ها
۵	فهرست جدول‌ها
۶	فهرست شکل‌ها
۱	<b>فصل ۱- فناوری نانو، صفحات گرافن، خواص و کاربرد ها</b>
۱	- ۱-۱- فناوری نانو چیست؟
۳	- ۱-۲- نانو ساختارهای کربنی
۳	- ۱-۲-۱- گرافن
۶	- ۲-۲-۱- گرافیت
۷	- ۳-۲-۱- نانولوله‌ی کربنی
۸	- ۴-۲-۱- فولرین‌ها
۱۰	- ۵-۲-۱- تروس (حلقه)
۱۰	- ۶-۲-۱- نانوبود
۱۱	- ۳-۱- کاربرد‌های فناوری نانو
۱۲	- ۴-۱- تاریخچه‌ی گرافن
۱۳	- ۵-۱- ابزارهای تشریح گرافن
۱۴	- ۱-۵-۱- میکروسکوپ نوری
۱۵	- ۲-۵-۱- میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
۱۵	- ۳-۵-۱- میکروسکوپ انتقال الکترون (TEM)
۱۶	- ۶-۱- روش‌های ساخت گرافن
۱۷	- ۱-۶-۱- ورقه ورقه کردن مکانیکی
۱۹	- ۲-۶-۱- رشد پشتیبانی شده
۲۱	- ۳-۶-۱- اکسید گرافن و رهیافت‌های شیمیایی مرطوب
۲۴	- ۴-۶-۱- روش فاز گازی بدون زیرلايه
۲۵	- ۷-۱- خواص متنوع گرافن
۲۵	- ۱-۷-۱- الکترونیک
۲۶	- ۲-۷-۱- اپتیک
۲۷	- ۳-۷-۱- مکانیک
۲۹	- ۸-۱- کاربرد‌های گرافن
۲۹	- ۱-۸-۱- تصویر برداری مستقیم از نانو مواد سخت و نرم
۳۰	- ۲-۸-۱- حسگرهای گرافن

۳۲	- نازک ترین روان کننده‌ی جامد	-۳-۸-۱
۳۲	- پیشینه‌ی پژوهش	-۹-۱
<b>۳۹</b>	<b>فصل ۲ - فرمولاسیون و روش‌های تحلیل صفحات گرافن.</b>	
۳۹	- ساختار اتمی و هندسه صفحه‌ی گرافن	-۱-۲
۴۳	- روش‌های مدل سازی صفحات گرافن	-۲-۲
۴۳	- مدل‌های مولکولی	-۱-۲-۲
۴۵	- مدل مکانیک محیط پیوسته	-۲-۲-۲
<b>۵۱</b>	<b>فصل ۳ - روش اجزاء محدود</b>	
۵۱	- مقدمه	-۱-۳
۵۴	- کمینه نمودن انرژی پتانسیل	-۲-۳
۵۶	- روش کاهش خطای معادلات دیفرانسیل حاکم	-۳-۳
۵۷	- روش حل گالرکین	3-3-1-
۵۸	- روابط حاکم بر صفحات گرافن	-۴-۳
<b>۶۰</b>	<b>فصل ۴ - بررسی خواص الاستیک و رشد ترک در صفحات گرافن.</b>	
۶۰	- مقدمه	-۱-۴
۶۱	- خواص الاستیک صفحات گرافن	-۲-۴
۶۱	- مدول کششی صفحات گرافن	-۱-۲-۴
۷۶	- مدول برشی صفحات گرافن	-۲-۲-۴
۸۴	- نسبت پواسون صفحات گرافن	-۳-۲-۴
۸۸	- اثر نقایص هندسی بر خواص الاستیک صفحات گرافن	-۳-۳-۴
۸۹	- اثر بر مدول کششی صفحه	-۱-۳-۴
۹۴	- اثر بر مدول برشی صفحه	-۲-۳-۴
۹۷	- رشد ترک در صفحات گرافن	-۴-۴
۹۷	- صفحه‌ی آرمچیر	-۱-۴-۴
۱۱۰	- صفحه‌ی زیگراگ	-۲-۴-۴
۱۲۳	- مقایسه‌ی مسیر پارگی	-۳-۴-۴
<b>۱۲۷</b>	<b>فصل ۵ - نتیجه‌گیری و پیشنهادات.</b>	
۱۲۷	- نتیجه‌گیری	-۱-۵
۱۳۰	- پیشنهادات	-۲-۵
<b>۱۳۱</b>	<b>فصل ۶ - منابع</b>	

## فهرست علایم و نشانه‌ها

### علامت اختصاری

### عنوان

$W_{body}(j)$	انرژی بارگذاری حجمی
$W_{surf}(j)$	انرژی بارگذاری سطحی
$u_\omega(j)$	انرژی پیچش خارج از صفحه
$u_\phi(j)$	انرژی پیچش زاویه دو سطحی
$u_\theta(j)$	انرژی خمس پیوند
$u_r(j)$	انرژی کشش پیوند
$\Lambda^e(j)$	انرژی کرنشی در حالت سه بعدی
$u_{vdw}(j)$	انرژی نیروهای واندروالس
$P_i(N)$	بار سطحی در راستای $i$
$\vec{C}$	بردار کایرال
$n$	تعداد گره
$\Delta\beta(rad)$	تغییر زاویه‌ی نسبی دو انتهای تیر
$\tau(Pa)$	تنش برشی
$\sigma(Pa)$	تنش کششی
$m(kg)$	جرم
$\theta_0(rad)$	زاویه‌ی اولیه‌ی پیوند
$\alpha(rad)$	زاویه‌ی چرخش انتهای تیر
$\theta(rad)$	زاویه‌ی کایرال
$k_t(N \text{ nm rad}^{-2})$	سختی پیچشی پیوند
$k_\theta(N \text{ nm rad}^{-2})$	سختی خمی پیوند
$k_r(N \text{ nm}^{-1})$	سختی کششی پیوند
$A(m^2)$	سطح مقطع
$t(nm)$	ضخامت صفحه
$L(nm)$	طول المان تیر
$r_0(nm)$	طول اولیه‌ی پیوند
$b(nm)$	طول صفحه
$r(nm)$	فاصله اتم کربن از اتم مجاور
$d(nm)$	قطر المان تیر
$\gamma$	کرنش برشی

$\varepsilon_T$	کرنش حرارتی
$\varepsilon$	کرنش طولی
$T$ (N.m)	گشتاور پیچشی
$M$ (N.m)	گشتاور خمشی
$G$ (Pa)	مدول برشی
$E$ (Pa)	مدول کششی
$J$ ( $m^4$ )	ممان اینرسی قطبی
$v$	نسبت پواسون
$F$ (N)	نیرو

## فهرست جداول‌ها

عنوان	صفحه
جدول ۱-۱: خواص فیزیکی گرافیت	۶
جدول ۱-۲: مزایا و معایب روش‌های ساخت گرافن	۱۷
جدول ۲-۱: پارامترهای هندسی صفحه‌ی گرافن	۴۳
جدول ۲-۴: مقایسه‌ی مدول کششی	۷۴
جدول ۳-۴: مقایسه‌ی تنش و کرنش شکست	۷۶
جدول ۴-۴: مقایسه‌ی مدول برشی	۸۴

## فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱: آرایش شش ضلعی منظم صفحه‌ی گرافن	۴
شکل ۱-۲: شبکه‌ی گرافن شامل دو زیر شبکه‌ی مثلثی در هم نفوذ کرده	۴
شکل ۱-۳: باند $\pi - \pi^*$ سازه‌ی گرافن	۵
شکل ۱-۴: گرافن پایه‌ی تمام نانو ساختارها	۵
شکل ۱-۵: شکل شماتیک گرافیت (تشکیل شده از سه لایه گرافن)	۷
شکل ۱-۶: یک نanolوله‌ی کربنی تک دیواره با انتهای بسته	۸
شکل ۱-۷: باکی بال	۹
شکل ۱-۸: ساختار یک نانو بود پایدار	۱۰
شکل ۱-۹: تکنیک‌های عمدۀ برای تشریح گرافن a) میکروسکوپ نوری b) میکروسکوپ نیروی اتمی c) میکروسکوپ انتقال الکترون	۱۳
شکل ۱-۱۰: گرافن ورقه‌شده به صورت میکرو مکانیکی. تصاویر نوری (a) گرافیت نازک (b) گرافن کم لایه و گرافن تک لایه (کنتراست روشن تر) روی یک لایه SiO <sub>2</sub> با ضخامت 300 nm	۱۴
شکل ۱-۱۱: گرافن رشد یافته روی نیکل a) تصویر نوری یک فیلم نیکل پیش-آراسته روی SiO <sub>2</sub> /Si (b) تصویر نوری گرافن رشد یافته و منتقل شده از سطح نیکل به زیرلایه ای دیگر.	۲۱
شکل ۱-۱۲: فرایند برهمنکش-اکسیداسیون برای تهییه GO, FGO و FG	۲۴
شکل ۱-۱۳: تصویر با وضوح اتمی از یک صفحه‌ی گرافن با ساختار کامل و تمیز ساخته شده با روش فاز گازی بدون زیرلایه. اتم‌های کربن در تصویر سفید به نظر می‌رسند	۲۵
شکل ۱-۱۴: شفافیت نوری a) تصویر میکروسکوپ نوری از کریستال‌های نازک GO کاهش یافته..... b) عبور در $\lambda \sim 550\text{ nm}$ به عنوان تابعی از ضخامت فیلم‌های نازک GO	۲۷
شکل ۱-۱۵: خواص مکانیکی a) نانو تورفتگی شماتیک AFM روی گرافن معلق. b) منحنی بارگذاری-باربرداری برای وسیله شکل a. c) طرح شماتیک یک تشدید کننده گرافن. d) منحنی دامنه در برابر فرکانس رزونانس برای مد بنیادی یک تشدید کننده‌ی گرافن تک لایه.	۲۸
شکل ۱-۱۶: یک تصویر با وضوح اتمی از یک نانو ذره‌ی طلا و سیترات در محیط اطرافش روی یک فیلم پشتیبانی گرافن	۳۰
شکل ۱-۱۷: حسگر زیستی دارای لایه‌ی گرافن	۳۲
شکل ۱-۱: بردارهای یکه‌ی a <sub>1</sub> و a <sub>2</sub> در مختصات گرافنی	۳۹
شکل ۱-۲: بردارهای کایرال C = a <sub>1</sub> + 3a <sub>2</sub>	۴۰
شکل ۱-۳: زاویه‌ی کایرال بین بردار C = a <sub>1</sub> + 3a <sub>2</sub> و محور مربوط به بردار یکه‌ی a <sub>1</sub>	۴۰
شکل ۱-۴: دو بردار C <sub>1</sub> و C <sub>2</sub> با یکدیگر هم ارز هستند.	۴۱

شکل ۲-۵: در ناحیه‌ی با رنگ تیره از صفحه، شرط $m \geq n$ برقرار است.	۴۱
شکل ۲-۶: کوتاه ترین مسیر مربوط به بردارهای کایرال و واحد‌های تکرار شونده‌ی آنها	۴۲
شکل ۷-۲: سه نوع صفحه‌ی گرافن زیگزاگ، آرمچیر و کایرال	۴۳
شکل ۸-۲: شبیه سازی نanolوله به روش قاب فضایی	۴۶
شکل ۹-۲: برهمکنش‌های بین اتمی در مکانیک مولکولی	۴۷
شکل ۱-۳: یک المان یک بعدی	۵۲
شکل ۲-۳: منحنی نیرو-کرنش پتانسیل مورس اصلاح شده.	۵۸
فقط تا کرنش ۱۹٪ (قسمت تیره) مدل شده است	۶۰
شکل ۱-۴: نمونه‌ی یک صفحه‌ی گرافن زیگزاگ ایجاد شده در محیط انسیس	۶۱
شکل ۲-۴: صفحه‌ی گرافن آرمچیر همراه با قیود و بارگذاری کششی	۶۳
شکل ۳-۴: منحنی تنش-کرنش برای صفحه‌ی آرمچیر $2.4157 \times 1.7229 \text{ nm}$	۶۴
شکل ۴-۴: تغییرات نسبت تنش به کرنش، بر حسب کرنش طولی برای صفحه‌ی آرمچیر $2.4157 \times 1.7229 \text{ nm}$	۶۴
شکل ۴-۵: مقایسه‌ی منحنی تنش-کرنش برای سه صفحه‌ی آرمچیر با ابعاد مختلف	۶۵
شکل ۴-۶: مقایسه‌ی نسبت تنش به کرنش برای سه صفحه‌ی آرمچیر با ابعاد مختلف	۶۶
شکل ۷-۴: منحنی تنش-کرنش برای صفحه‌ی زیگزاگ $2.2151 \times 1.9894 \text{ nm}$	۶۷
شکل ۸-۴: تغییرات نسبت تنش به کرنش بر حسب کرنش برای صفحه‌ی زیگزاگ $2.2151 \times 1.9894 \text{ nm}$	۶۷
شکل ۹-۴: مقایسه‌ی منحنی تنش-کرنش برای سه صفحه‌ی زیگزاگ با ابعاد مختلف	۶۸
شکل ۱۰-۴: مقایسه‌ی مدول کششی برای سه صفحه‌ی زیگزاگ با ابعاد مختلف	۶۸
شکل ۱۱-۴: منحنی تنش-کرنش صفحه‌ی کایرال (۱و۳) با اندازه‌ی $3.3789 \times 1.8129 \text{ nm}$	۶۹
شکل ۱۲-۴: تغییرات نسبت تنش به کرنش بر حسب کرنش صفحه‌ی کایرال (۱و۳) با اندازه‌ی $3.3789 \times 1.8129 \text{ nm}$	۷۰
شکل ۱۳-۴: منحنی تنش-کرنش برای سه صفحه‌ی کایرال (۱و۳) با ابعاد مختلف	۷۰
شکل ۱۴-۴: تغییرات نسبت تنش به کرنش بر حسب کرنش برای سه صفحه‌ی کایرال (۱و۳) با ابعاد مختلف	۷۰
شکل ۱۵-۴: مقایسه‌ی منحنی تنش-کرنش برای دو صفحه با کایرالیتی متفاوت	۷۱
شکل ۱۶-۴: تغییرات نسبت تنش به کرنش بر حسب کرنش برای دو صفحه با کایرالیتی متفاوت	۷۲
شکل ۱۷-۴: مقایسه‌ی منحنی تنش-کرنش برای سه صفحه‌ی با کایرالیتی متفاوت	۷۳
شکل ۱۸-۴: تغییرات نسبت تنش به کرنش بر حسب کرنش برای سه صفحه با کایرالیتی متفاوت	۷۳
شکل ۱۹-۴: منحنی تنش-کرنش نanolوله‌ی آرمچیر و زیگزاگ تحت بارگذاری کششی	۷۵
شکل ۲۰-۴: صفحه‌ی گرافن آرمچیر همراه با قیود و بارگذاری برشی به صورت جابجایی	۷۶
شکل ۲۱-۴: منحنی تنش-کرنش برشی برای صفحه‌ی آرمچیر $2.4157 \times 1.7229 \text{ nm}$	۷۸

شکل ۴-۲۲: تغییرات نسبت تنش به کرنش برشی بر حسب کرنش	۷۸
برای صفحه‌ی آرمچیر $2.4157 \times 1.7229 \text{ nm}$	
شکل ۴-۲۳: مقایسه‌ی منحنی تنش-کرنش برشی برای سه صفحه‌ی آرمچیر با ابعاد مختلف	۷۹
شکل ۴-۲۴: تغییرات نسبت تنش به کرنش برشی بر حسب کرنش	۸۰
برای سه صفحه‌ی آرمچیر با ابعاد مختلف	
شکل ۴-۲۵: منحنی تنش-کرنش برشی برای صفحه‌ی زیگزاگ با اندازه $2.2151 \times 1.9894 \text{ nm}$	۸۱
شکل ۴-۲۶: تغییرات نسبت تنش به کرنش برشی بر حسب کرنش	۸۱
برای صفحه‌ی زیگزاگ با اندازه $2.2151 \times 1.9894 \text{ nm}$	
شکل ۴-۲۷: مقایسه‌ی منحنی تنش-کرنش برشی برای دو صفحه‌ی زیگزاگ با ابعاد مختلف	۸۲
شکل ۴-۲۸: تغییرات نسبت تنش به کرنش برشی بر حسب کرنش	۸۳
برای دو صفحه‌ی زیگزاگ با ابعاد مختلف	
شکل ۴-۲۹: نسبت پواسون بر حسب کرنش طولی	۸۵
برای صفحه‌ی آرمچیر $2.4157 \times 1.7229 \text{ nm}$	
شکل ۴-۳۰: مقایسه‌ی نسبت پواسون سه صفحه‌ی آرمچیر با ابعاد متفاوت	۸۶
شکل ۴-۳۱: نسبت پواسون بر حسب کرنش طولی	۸۷
برای صفحه‌ی زیگزاگ $2.2151 \times 1.9894 \text{ nm}$	
شکل ۴-۳۲: مقایسه‌ی نسبت پواسون برای سه صفحه‌ی زیگزاگ با ابعاد مختلف	۸۸
شکل ۴-۳۳: مدل صفحه‌ی آرمچیر با نقص SW	۸۹
شکل ۴-۳۴: مدل صفحه‌ی زیگزاگ با نقص جای خالی	۸۹
شکل ۴-۳۵: منحنی تنش-کرنش برای سه صفحه‌ی آرمچیر متفاوت	۹۰
شکل ۴-۳۶: تغییرات نسبت تنش به کرنش برای سه صفحه‌ی آرمچیر مختلف	۹۱
شکل ۴-۳۷: تأثیر نقص جای خالی بر نانولوله‌ی آرمچیر	۹۲
شکل ۴-۳۸: منحنی تنش-کرنش برای سه صفحه‌ی زیگزاگ متفاوت	۹۳
شکل ۴-۳۹: تغییرات نسبت تنش به کرنش بر حسب کرنش برای سه صفحه‌ی زیگزاگ متفاوت	۹۳
شکل ۴-۴۰: منحنی تنش-کرنش برشی برای سه صفحه‌ی آرمچیر متفاوت	۹۴
شکل ۴-۴۱: تغییرات نسبت تنش به کرنش برشی برای سه صفحه‌ی آرمچیر متفاوت	۹۵
شکل ۴-۴۲: منحنی تنش-کرنش برشی سه صفحه‌ی زیگزاگ متفاوت	۹۶
شکل ۴-۴۳: تغییرات نسبت تنش به کرنش برشی برای سه صفحه‌ی زیگزاگ متفاوت	۹۶
شکل ۴-۴۴: مسیر پارگی صفحه‌ی گرافن آرمچیر با یک نقص SW	۹۸
و اعمال بارگذاری به صورت جابجایی	
شکل ۴-۴۵: ترتیب شکست المان‌ها در صفحه با نقص SW و بارگذاری به صورت جابجایی	۹۹
شکل ۴-۴۶: مسیر پارگی صفحه‌ی گرافن آرمچیر با یک نقص SW	۱۰۰
و اعمال بارگذاری به صورت نیرویی	

- شکل ۴-۴۷: ترتیب شکست المان ها در صفحه با نقص SW و بارگذاری به صورت نیرویی ..... ۱۰۱
- شکل ۴-۴۸: مسیر پارگی صفحه ای گرافن آرمچیر با یک نقص جای خالی ..... ۱۰۲
- و اعمال بارگذاری به صورت جابجایی ..... ۱۰۳
- شکل ۴-۴۹: ترتیب شکست المان ها در صفحه با نقص جای خالی و بارگذاری به صورت جابجایی ..... ۱۰۴
- شکل ۴-۵۰: مسیر پارگی صفحه ای گرافن آرمچیر با یک نقص جای خالی ..... ۱۰۵
- و اعمال بارگذاری به صورت نیرویی ..... ۱۰۶
- شکل ۴-۵۱: ترتیب شکست المان ها در صفحه با نقص جای خالی و بارگذاری به صورت نیرویی ..... ۱۰۷
- شکل ۴-۵۲: مسیر پارگی صفحه ای گرافن آرمچیر طویل با یک نقص جای خالی ..... ۱۰۸
- شکل ۴-۵۳: ترتیب شکست المان ها در صفحه ای طویل با نقص جای خالی ..... ۱۱۰
- و بارگذاری به صورت نیرویی ..... ۱۱۱
- شکل ۴-۵۴: شکست در صفحه ای زیگزاگ دارای نقص SW و بارگذاری به صورت نیرویی ..... ۱۱۱
- شکل ۴-۵۵: مسیر پارگی در صفحه ای زیگزاگ دارای نقص SW و بارگذاری به صورت جابجایی ..... ۱۱۲
- شکل ۴-۵۶: ترتیب شکست المان ها در صفحه ای زیگزاگ با نقص SW و بارگذاری به صورت جابجایی ..... ۱۱۳
- شکل ۴-۵۷: مسیر پارگی صفحه ای زیگزاگ با نقص جای خالی رو به پایین و بارگذاری به صورت جابجایی ..... ۱۱۴
- شکل ۴-۵۸: ترتیب شکست المان های صفحه ای زیگزاگ با نقص جای خالی رو به پایین و بارگذاری به صورت جابجایی ..... ۱۱۵
- شکل ۴-۵۹: مسیر پارگی صفحه ای زیگزاگ با نقص جای خالی رو به بالا و بارگذاری به صورت جابجایی ..... ۱۱۷
- شکل ۴-۶۰: ترتیب شکست المان های صفحه ای زیگزاگ با نقص جای خالی رو به بالا و بارگذاری به صورت جابجایی ..... ۱۱۸
- شکل ۴-۶۱: مسیر پارگی صفحه ای زیگزاگ با نقص جای خالی رو به پایین و بارگذاری به صورت نیرویی ..... ۱۱۹
- شکل ۴-۶۲: ترتیب شکست المان های صفحه ای زیگزاگ با نقص جای خالی رو به پایین و بارگذاری به صورت نیرویی ..... ۱۲۰
- شکل ۴-۶۳: مسیر پارگی صفحه ای زیگزاگ با نقص جای خالی رو به بالا و بارگذاری به صورت نیرویی ..... ۱۲۱
- شکل ۴-۶۴: ترتیب شکست المان های صفحه ای زیگزاگ با نقص جای خالی رو به بالا و بارگذاری به صورت نیرویی ..... ۱۲۲
- شکل ۴-۶۵: مسیر پارگی در صفحه ای گرافن زیگزاگ ..... ۱۲۳
- شکل ۴-۶۶: مسیر پارگی در صفحه ای گرافن زیگزاگ با دو نوع نقص جای خالی ..... ۱۲۳

- شکل ۴-۶۷: مسیر پارگی در صفحه‌ی گرافن زیگزاگ دارای یک پیوند ضعیف ..... ۱۲۴
- شکل ۴-۶۸: ترتیب شکست المان‌ها در صفحه‌ی گرافن زیگزاگ دارای یک پیوند ضعیف ..... ۱۲۵
- شکل ۴-۶۹: رشد ترک در نانولوله‌ی زیگزاگ همراه با یک پیوند ضعیف ..... ۱۲۶
- شکل ۴-۷۰: رشد ترک در نانولوله‌ی زیگزاگ همراه با یک پیوند ضعیف ..... ۱۲۶

# فصل ۱ - فناوری نانو، صفحات گرافن، خواص و کاربرد ها

## ۱-۱- فناوری نانو چیست؟

نانو از لغت یونانی Nanos یعنی کوچک مشتق شده و به معنی یک میلیاردم هر چیز است. بشر از همان ابتدای تاریخ به مقیاس های خیلی بزرگ و خیلی کوچک در طبیعت توجه داشته که این توجه بیشتر در محدوده‌ی نیاز های روزمره اش بوده است. با رشد جمعیت کره‌ی خاکی و محدود شدن منابع انرژی توجه به منابع جدید زیاد شده و با رشد دانش بشری توجه به مقیاس های بسیار کوچک، افزایش یافته است. فناوری نانو و ساختارهای تولید شده از آن، سال‌ها است که در طبیعت وجود داشته و در حال حاضر نیز ساختارهایی در مقیاس نانو در طبیعت شکل گرفته و می‌گیرد. فناوری نانو به فناوری اطلاق می‌شود که امکان ساخت و تولید مواد و ترکیبات مصنوعی در آزمایشگاه را برای انسان مقدور می‌سازد.

با توجه به اینکه در مقیاس نانو خواص مواد تغییر می‌کند و باعث تولید مواد جدیدی با عملکرد بهتر می‌گردد، لذا این فناوری توانسته است توجه کشورهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی را به خود جلب کند. فناوری نانو امکان دست کاری و آرایش دوباره‌ی اتم‌ها در اختیار انسان‌ها قرار داده است تا آنها بتوانند با تغییر در چیدمان اتم‌ها علاوه بر امکان تولید مواد جدید با خواص دلخواه خود، موادی با ساختار ساده و ارزان تولید نمایند. به دلیل اینکه قوانین فیزیک کلاسیک در ابعاد نانو، تغییر می‌کند و قوانین فیزیک کوانتوم حاکم می‌شود، مواد در مقیاس نانو از خود خصوصیات جدیدی نشان می‌دهند. فناوری نانو که به فناوری مادون ریز معروف است، در آینده‌ای نزدیک تمام جنبه‌های زندگی بشر را متأثر خواهد نمود. علم مهندسی دگرگون خواهد شد و همچنین خواص مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی، نوری و دیگر خواص مواد در ابعاد نانومتری قابل درک، شناسایی و تحلیل خواهد شد و تولید با هزینه، صرف وقت و انرژی کمتر انجام می‌گیرد. در آینده‌ای نه چندان دور به کمک این فناوری، محصولات با خواص بهتر، مطلوب‌تر، دوام بیشتر و هزینه‌ی تولید و نگهداری کمتری تولید خواهند شد.

به طور کلی فناوری نانو با دیگر علوم در تمامی گرایش ها هم راستا بوده و در واقع این فناوری مکملی برای علوم و فناوری های دیگر و نه رقیبی برای آنهاست. تجربه های گذشته‌ی توسعه‌ی فناوری های مختلف نشان داده است که نداشتن دور اندیشی در زمینه‌ی فناوری های در حال توسعه و نداشتن آمادگی کافی برای مواجهه با گسترش آنها لطمه های جبران ناپذیری به دولت ها و ملت ها زده است، بنابراین در دنیای کنونی که سرعت تحولات و پیشرفت ها به بیشترین مقدار خود تا به حال رسیده است، داشتن دور اندیشی برای مواجهه با آینده، در همه‌ی زمینه‌ها ضروری است.

دور اندیشی، آمادگی برای آینده است تا با شناخت فرصت ها و تهدید های احتمالی، شرایط لازم برای دستیابی هر چه بهتر به سود رقابتی، بهبود کیفیت زندگی و توسعه‌ی پایدار مشخص شود. در حقیقت دور اندیشی ابزاری لازم برای بقا در آینده و دفع خطرات و تهدید ها و استفاده از فرصت های آتی است. فناوری نانو یکی از فناوری های جدید است که آینده‌ی بسیار روشنی برای آن پیش‌بینی می‌شود. گستردنگی دامنه‌ی تأثیر این فناوری بسیار زیاد بوده و گفته می‌شود این فناوری می‌تواند بیشتر جنبه های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار دهد. از این جهت به کارگیری شیوه‌ی برخوردي مناسب با این پدیده و داشتن شناخت کافی از زمینه‌های مختلف آن، بسیار مهم است.

برای دور اندیشی فناوری نانو، در مرحله‌ی اول باید شناخت خوبی از عناصر تشکیل دهنده‌ی این فناوری به دست آورد. بدیهی است که هر چه این شناخت کامل‌تر باشد، دور اندیشی بر اساس آن ساده‌تر و دقیق‌تر خواهد بود. برای این شناخت کافی است تقسیم بندی مناسبی از اجزای این فناوری داشته باشیم، به گونه‌ای که رابطه‌ی بین قسمت‌های مختلف مشخص باشد. داشتن این تقسیم بندی به شناخت ابعاد مختلف این فناوری کمک می‌کند [۱].

واژه‌ی فناوری نانو اولین بار توسط نوریو تاینگوچی<sup>۱</sup> استاد دانشگاه علوم توکیو در سال ۱۹۷۴ مورد استفاده قرار گرفت. وی این واژه را برای توصیف ساخت مواد دقیقی که تلرانس ابعادی آنها در حد نانومتر

<sup>۱</sup> Norio Taniguchi

می باشد، به کار برد. در سال ۱۹۸۶ این واژه توسط اریک درکسلر<sup>۱</sup> در کتابی تحت عنوان: " موتور آفرینش: آغاز دوران فناوری نانو " تعریف مجدد شد. او این واژه را به شکل عمیق تری در رساله‌ی دکتری خود مورد بررسی قرار داده و بعد‌ها آنرا در کتابی به عنوان " نانو مجموعه‌ها، ماشین‌های مولکولی، چگونگی ساخت و محاسبات آنها " توسعه داد. هدف فناوری نانو تولید مولکولی یا ساخت اتم به اتم و مولکول به مولکول مواد و ماشین‌ها توسط بازوهای روبات برنامه‌ریزی شده، در مقیاس نانومتر است [۲].

حدود نیم قرن پیش ریچارد فایمن<sup>۲</sup>، متخصص کوانتم نظری و دارنده‌ی جایزه‌ی نوبل، در هنگام گرفتن جایزه‌ی خود نظریه‌ی جدیدی مطرح کرد. او در سخنرانی خود در سال ۱۹۵۹ عنوان کرد: " آن پایین فضای بسیاری هست. اصول فیزیک، تا جایی که من توانایی فهمش را دارم، مخالفتی با ساختن اتم به اتم چیزها ندارد ".

## ۱-۲-۱- نانو ساختارهای کربنی

ساختارهای کربنی مقیاس نانو را می‌توان بر اساس شکل هندسی شان به دسته‌های مختلفی تقسیم بنده کرد. در اینجا چند مورد از مهم‌ترین این ساختارها معرفی می‌شوند.

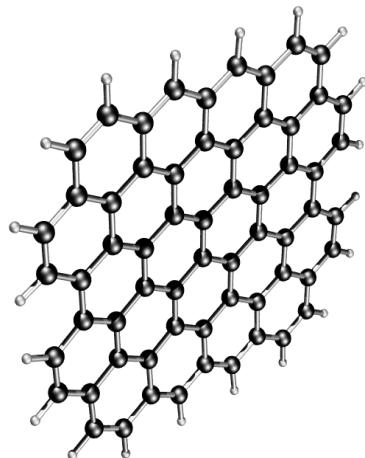
### ۱-۲-۱- گرافن

گرافن از اتم‌های کربن با پیوند  $sp^2$ <sup>۳</sup>، آرایش یافته در یک شبکه‌ی لانه زنبوری<sup>۳</sup> دو بعدی ساخته شده است (شکل ۱-۱). شبکه‌می تواند به صورت ترکیب دو زیر شبکه‌ی مثلثی دیده شود که اتم‌های یک زیر شبکه در مرکز مثلث تعریف شده با طول پیوند بین اتمی کربن-کربن،  $a_{c-c} = 1.421 \text{ \AA}$ ، می‌باشند (شکل ۱-۲). سلول واحد شامل دو اتم کربن بوده و تحت چرخش  $120^\circ$  حول هر اتم ناوردا است.

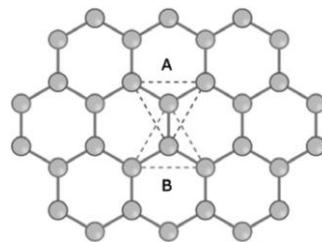
<sup>1</sup> Eric Drexler

<sup>2</sup> Richard Feynman

<sup>3</sup> Honey comb



شکل ۱-۱: آرایش شش ضلعی منظم صفحه‌ی گرافن



شکل ۱-۲: شبکه‌ی گرافن شامل دو زیرشبکه‌ی مثلثی در هم نفوذ کرده [۳]

هر اتم یک اوربیتال s و دو اوربیتال درون صفحه‌ای p دارد که در پایداری مکانیکی صفحه‌ی کربن مشارکت دارند. اوربیتال p باقیمانده به صورت عمود بر صفحه‌ی مولکولی آرایش می‌یابد. در محدوده‌ی کم انرژی، در همسایگی نقاط k و  $k'$ ، آن دو پیوند به هم رسیده و دره‌های مخروطی شکل<sup>۱</sup> به وجود می‌آورند (شکل ۱-۳). در این محدوده‌ی کم انرژی، رابطه‌ی پراکندگی مومنتوم-انرژی خطی است. در محدوده‌ی انرژی بالا رابطه‌ی مومنتوم-انرژی خطی خیلی معتبر نیست و باند‌ها در مععرض یک اعوجاج ناشی از ناهمسانگردی<sup>۲</sup> هستند، که همچنین به عنوان اعوجاج سه‌گوش<sup>۳</sup> شناخته می‌شوند. به محض انشاستن تک لایه‌های گرافن روی هم‌دیگر، ابتدا گرافن دو لایه بدست می‌آید، که مجموعه‌ی خواص

<sup>1</sup> Conical-shaped

<sup>2</sup> Anisotropy

<sup>3</sup> Trigonal warping